

537PY19A, K537PY19A, K537PY19B, KP537PY19

Микросхемы представляют собой оперативное запоминающее устройство емкостью 64 кбит (65 536 × 1). Содержат 400 000 интегральных элементов. Корпус типа 4183.28-3 и типа 239.24-2, масса не более 4 г.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,35 В
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,5 В
Входной ток низкого уровня	≤ −0,9 мкА
Входной ток высокого уровня	≤ 0,9 мкА
Ток потребления в режиме хранения при $U_n = 5$ В	≤ 0,5 мА
Динамический ток потребления при $U_n = 5$ В, $f = 1$ МГц	≤ 70 мА
Выходной ток низкого уровня в состоянии «выключено»	≤ −4 мкА
Выходной ток высокого уровня в состоянии «выключено»	≤ 4 мкА
Время выборки адреса, разрешения, хранения:	
K537PY19A, KP537PY19	≤ 65 нс
K537PY19B	≤ 95 нс
Время выборки считывания:	
K537PY19A, KP537PY19	≤ 35 нс
K537PY19B	≤ 65 нс
Время выборки записи:	
K537PY19A, KP537PY19	≤ 55 нс
K537PY19B	≤ 85 нс
Входная емкость	≤ 8 пФ
Выходная емкость	≤ 12 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Значение статического потенциала	150 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2,4... U_n В
Выходной ток низкого уровня	≤ 3,2 мА

Выходной ток высокого уровня	$\leq -2 $ мА
Время установления сигнала записи относительно сигнала адреса, входной информации, сигнала разрешения	≥ 20 нс
Время сохранения сигнала адреса относительно сигнала записи	≥ 20 нс
Время сохранения сигнала разрешения относительно сигнала записи	≥ 20 нс
Длительность сигнала записи:	
K537PY19A, KP537PY19	≥ 40 нс
K537PY19Б	≥ 60 нс
Время фронта нарастания (спада) входного сигнала	$\leq 7,5$ нс
Емкость нагрузки	≤ 50 пФ
Температура окружающей среды	$-10...+70$ °С